



Polarization Terahertz Spectroscopy Application to Theophylline Anhydrous Single Crystal for Vibrational Mode Assignment

Purpose

Supply a system (hardware and software)

- for THz vibrational mode assignment
- to obtain basic data to apply THz spectra
- to pharmaceutical Product Quality Control

Experiment

- · Single crystal growth of Theophylline anhydrous
- Polarization THz spectroscopy of Theophylline anhydrous crystal at low temperature
- Comparison absorption frequencies and intensities between measurements and calculations

Theophylline anhydrous drug for respiratory diseases



anhydrous

Crystal growth from aqueous solution

 low temperature

hydrous

nperature

@1013 hPa

Theophylline monohydrate

Air flow

ոլոլո

heate

solution

C₇H₈N₄O₂ •H₂O •H₂O

Summary

> A single crystal of theophylline anhydrite, large and thin enough for wide range THz transmittance spectroscopy could be successfully fabricated

by Temperature Difference Method (TDM) in aqueous solution.

> Wide range polarization spectroscopy at low temperature was shown to be useful to assign vibration modes with the aid of DFT calculation.



Sample preparation

Single crystal growth of Theophylline

for THz transmittance spectroscopy

Results and discussion

Advantage

CW GaP THz Spectrometer

Calculation

DFT (Density Functional Theory) calculation with periodic boundary condition Software package CRYSTAL09

Geometry optimization start from crystal structure

defined by X-ray diffraction at room temperature Y. Ebisuzaki, P. Boyle and J. Smith, Acta Cryst. (1997), C53, 777-77

<100>

<010> <001>

B3LYP/6-31G(d.p) level

Fixed cell parameter















equency (THz)	Absorption (a.u.)	Direction	Frequency (THz)	Intensity (km/mol)	Directio
0.85	_	<100> 🛰	0.696	0.80	<010>
1.00	0.240	-0105	0.737	0.99	<001>
1.06	0.348	<010>	0.796	1.18	<100>
1 21	0.026	<001>	1.212	4.74	<010>
1.21	0.020	<0012	1.235	3.65	<001>
1 47	_	<100> **	1.344	1.80	<100>
1.47		100-	1.723	2.84	<100>
1.761	0.179	<001>	1.726	0.14	<010>
			1.955	19.64	<001>
1.797	-	<010> 🦈	2.160	0.04	<010>
			2.190	0.14	<001>
2.084	0.056	<010> 🥂	2.663	2.50	<010>
			3.477	0.10	<001>
2.788	0.099	<010> 🕬	3.562	1.34	<100>
		6	3.616	0.68	<010>
2.853	0.042	<001> 🥂	3.993	18.13	<001>
			4.049	20.46	<100>
3.913	0.496	<001> -	4.170	58.02	<010>
4.070	0.074		4.419	4.83	<100>
4.070	0.971	<010> -	4.604	3.23	<010>
4 200	_	-001>	4.777	1.02	<001>
4.390	_	<0012 S.	4.793	5.71	<100>
5.112	0 162	<010>	4.958	3.04	<010>
	0.102	-010	5.058	5.55	<001>
			5.063	10.55	<100>
			5.462	17.39	<100>
			5.466	9.37	<010>
			5.469	0.59	<001>





Wide range and high resolution CW THz spectrometer combined with GaP THz signal generator and mechanically cooled bolometer

Motivation



Improvement of CW GaP THz Spectrometer



Next Step



Summary

CW GaP THz Spectrometer

combining with a CW THz SG as a light source and a bolometer detector cooled by a mechanical cooler



The spectrometer is now working as non-stop system

- High accuracy
- High resolution
- ♦ Wide dynamic range
- ♦ High stability
- Long lifetime (durability)
- Easy maintenance
- Low equipment cost
- Low running cost

Observation of THz wave output by an oscilloscope

THz wave output with high power fiber laser

Next target develop practical industrial applications





セルロース誘導体の糊化作用が水和キサンチン化合物の 脱水に与える影響及び脱水・非晶質化メカニズムの分子振動解析

背景と目的

の変化に着目



局所振動解析から推察される非晶質化におけるテオフィリン2分子の位置関係



フォトキャパシタンス測定とは

微細化・高集積化が進むVLSIやULSI製作では、極微量の混入不純物が半導体製品の歩留りや信頼性等に深刻な影響を与えます。フォトキャパシタンス測定(PHCAP)は、このような極微量の汚染不純物を高感度かつ定量的に検出することができます。



上の図は従来用いられている微量不純物検出法の感度比較です。化学的手法で最も高感度なものでは検出感度が1ppt(10⁻¹²)以下になりますが、固体半導体を測定対象とする場合は複雑で面倒な前処理が必要となり、たいへん面倒です。一方、光・電気的手法は不純物が形成する欠陥準位を検出するので、非破壊測定である上に、容易に高感度が得られます。その中でもフォトキャパシタンス測定は、他の測定法に比べて感度や定量性の面で優れています。

フォトキャパシタンス測定の原理

pn接合の空乏層中では、アクセプタイオ ン(-)とドナイオン(+)および、欠陥準位 に捕獲された電子(あるいはホール)の電 荷がつりあっています(右図)。欠陥に捕獲 された電子は、照射される単色光(単ーエ ネルギ)からエネルギをもらって、空乏層 の外へ出て行きます。すると、空乏層中で は新たな電荷のつりあいが必要となり、結 果的に空乏層幅が変化します。 空乏層幅は

C=ɛ/W (C: pn接合容量値、ɛ: 半 導体の誘電率、W: 空乏層幅) で示されるように、接合容量値の関数で す。

つまり、照射光エネルギーに対する接合 容量値の変化から、欠陥準位のエネルギ と密度を知ることができます。



フォトキャパシタンス測定装置

製造:自作

設置場所∶2階 411 室

目的

半導体結晶中の欠陥(= 深い準位)の測定

○ 接合を作り、空乏層中のキャリアの励起を用いる方法

- フォトキャパシタンス法 (PHCAP)
- Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS)
- Isothermal Capacitance Transient Spectroscopy (ICTS) その他
- 接合を必要としない方法
 - ●フォトルミネッセンス法 (PL)
 - ●光吸収法

その他

PHCAP測定の特徴

- 深い準位の濃度を正確に求めることができる
- 照射する単色光の分解能に依存する高いエネルギー分解能
- 熱励起できないほどの深い準位も光により励起できる
- 深い準位の伝導帯、価電子帯それぞれとの関係を求められる

装置の概要



遠赤外·THz波長域用検出器

製造∶QMC Instruments Ltd. 型番∶QNbB/Dry



連続波テラヘルツ分光スペクトル測定装置の特徴



蒸気圧制御温度差法による 液相結晶成長装置

製造:自作

設置場所:2階 結晶評価室

